

2SD256, 2SD257, 2SD258, 2SD259

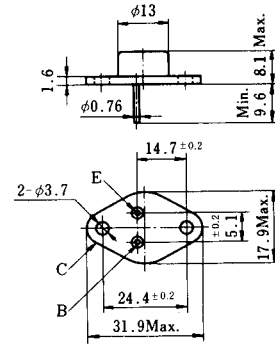
■シリコンNPN両面拡散形トランジスタ

- 一般用
- 通信産業用
- 指定通信工業用品種

■最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記 号	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	60V	90V	110V	130V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	40V	60V	80V	100V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	6V			
コレクタ電流	I_C	4A			
ベース電流	I_B	1A			
許容コレクタ損失	P_C	25W (フランジ温度25°C)			
接合部温度	T_j	150°C			
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150°C			

外形寸法* (単位: mm)
JEDEC(TO-66), EIAJ(TC-16A, TB-23)



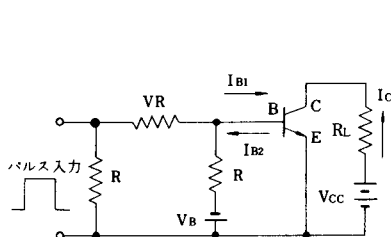
■電気的特性 (Ta=25°C)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
最大コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 20V$	10 μA			
最大エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V$	200 μA			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	$I_C = 50mA$	40V	60V	80V	100V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 4V$ $I_C = 1A$	40Min. 80Typ.			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2A$ $I_B = 0.4A$	1.0V Max. 0.2V Typ.			
しゃ断周波数	$f_{\alpha b}$	$V_{CB} = 10V$ $I_E = -0.2A$	8MHz Typ. 4MHz Min.			

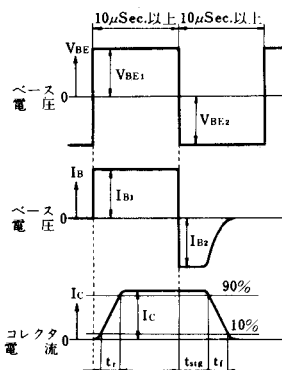
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	t_r ($\mu Sec.$)	t_{stg} ($\mu Sec.$)	t_f ($\mu Sec.$)
6	3	2	400	-100	1.2	1.6	1.7

スイッチング特性測定回路



測 定 条 件



周囲温度と最大許容損失

